



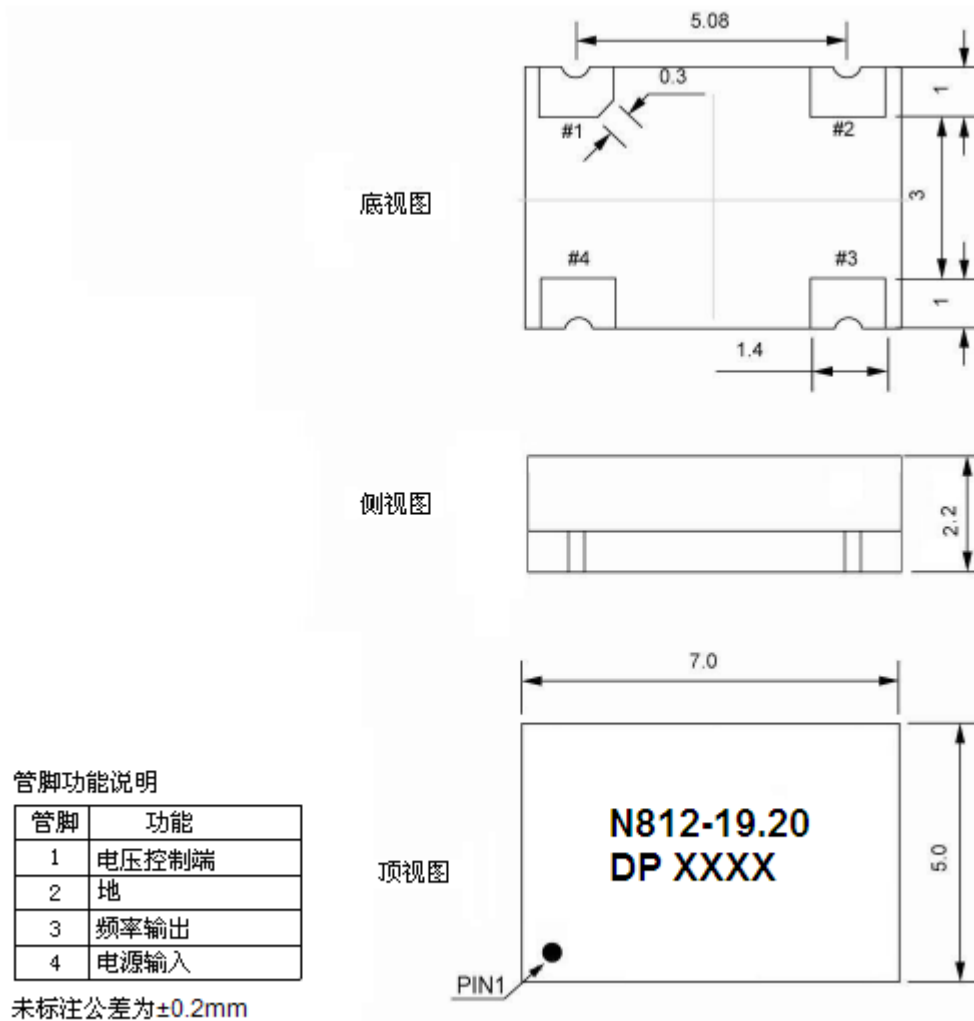
1、电性能

型号: T75B-N812-19.20MHz						
项目	指标描述	指标			单位	测试条件
		最小值	典型值	最大值		
输出	频率	19.20			MHz	
	波形	LVCMOS				
	低电平			0.4	V	V _{cc} =3.3V, O _{load} =15pF
	高电平	2.7			V	V _{cc} =3.3V, O _{load} =15pF
	占空比	45	50	55	%	
	上升/下降时间 (10%~90%)			8	ns	@25°C
	带载		15		pF	
频率稳定度	温度特性	-0.5		+0.5	ppm	温度范围-30°C 到 70°C, 参照 T _A =25°C, V _{cc} =3.3V, V _C =1.65V, O _{load} =15pF
	初始频率准确度	-0.5		+0.5	ppm	参照 T _A =25°C, V _{cc} =3.3V, V _C =1.65V 测试结果; 出厂后 30 天内, 开机 5s 后测试
	电源特性	-0.2		+0.2	ppm	参照 T _A =25°C, V _{cc} 从 3.14V 到 3.46V, V _C =1.65V, O _{Load} =15pF
	负载特性	-0.2		+0.2	ppm	负载变化量 5%, 参照 T _A =25°C, V _{cc} =3.3V, V _C =1.65V, O _{Load} =15pF
	日老化	-0.02		+0.02	ppm	T _A =25°C, V _{cc} =3.3V, V _C =1.65V, 开机 1 小时后连续测试
	年老化	-1		+1	ppm	
电气特性	电流		4		mA	@25°C, V _{cc} =3.3V, V _C =1.65V, O _{load} =15pF
	供电电压	3.14	3.3	3.46	V	
压控特性	频率变化范围			-8	ppm	V _C =0V. 参照 V _C =1.65V
		-0.5		+0.5	ppm	V _C =1.65V. 参照 19.20MHz 精准频点
		+8			ppm	V _C =3.3V. 参照 V _C =1.65V
	线性度			10	%	
	斜率	正斜率				
	输入阻抗	100			KOhm	
相位噪声	相位噪声		-135		dBc/Hz	1KHz
	可工作温度	-30		+70	°C	
	存储温度	-40		+85	°C	



环境特性	振动	测试条件: 0.75mm; 加速度: 10g; 10Hz~2000Hz, 每 30 分钟为一个循环, 每个方向测试 2 小时 (3 个方向 X, Y, Z), IEC 68-2-06 Test Fc
	冲击	100g; 6ms; 半正弦波(3 个方向 X, Y, Z), IEC 68-2-27 Test Ea/Severity 50A
	跌落	从100cm高度自由下坠到混凝土或钢制成的平滑、坚硬的刚性表面 IEC 68-2-32

2、机械结构(mm)



注: 1) 底视图为焊盘正对着观察者, 参考重量约为0.3g

2) 打标图解说:

DP XXXX

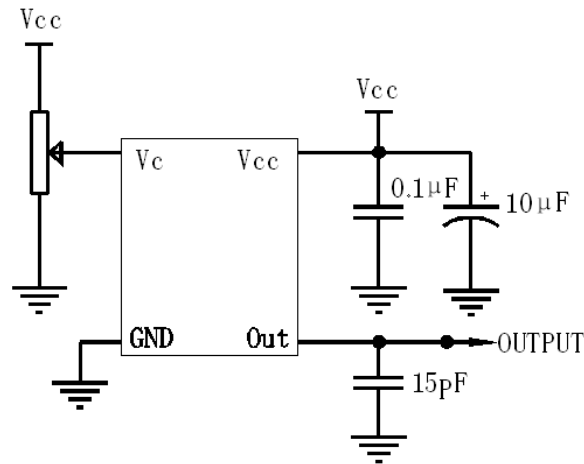
1) DP 代表: DAPU

2) 前两个 XX 代表: 周

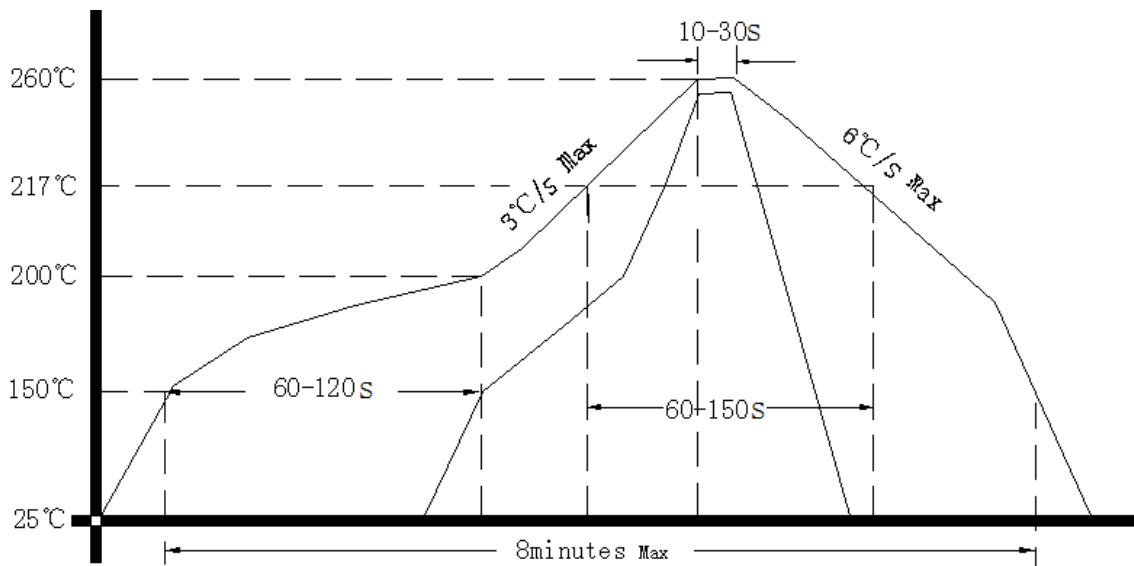
3) 后两个 XX 代表: 年



3、测试电路



4、回流焊曲线图(RoHS)



5、载带盘装 (单位:mm)

